

"#z,+ \$ IGBT 18N G ÄEiE> AYL6,+ \$ { •A'AuP`A•
ä NY1 Ô 5` HEiE> v { •A'AuP`A•,X IGBT 18N4"

+ Ñ/¥ :L6,+ \$-è0J Ä 1 B1T/Ä " AYL6,+ \$ " ÅA'Au-è ¥,X4±4ì U { U
J '1u Ä“Insulated Gate Bipolar Transistor È1T/Ä IGBT" Å2I ē { •b 1! ü "#z
,+ \$ YL\$ @ ì Ä 1 B1T/Ä" "#z,+ \$ " Å,X 18N G Ä P#(ä s È ØNM-D E'
A'Au?U" È Ü «- "#z,+ \$ 1 YZ NY1 Ô 5` HEiE> v { •A'AuP`A•,X IGBT
18N4" È •!7 š Ü Ü 0 1 E- Ô!9 || | Ñ {7¾ IGBT { •,X û MG£*ó {E-/ß È 1
} |E- r,, NY IGBT { i ê,X,Å Ü Ä

E- ö#(ä s,X { •G,*ü Planar NPT < È4§ X È?~ 15-43A /1200V ÄE- þ { •
M6 å S*ü+ < h*üNZ ³ È,Å !!7+ NY:+ á,X S+ Õ i v A@*üA~ Ä

"#z,+ \$ YL\$ @ ìKS ó 1 9 ñ õ { :-è Ü 0,X õ ä È å NY:+ á/¥-èL6 ž û:
ü „ _+ o+ \$ < È •M6,X T Ü 0+ 9 AE Ä ü!8 IGBT NM,Å Ü 0 ! È •Ò6(
Ü+ \$/¥ T û :+ AË J ä s9^c k Z Ñ S „ _+ o+ \$NM,Å,X Õ Ä ü IGBT NM,Å k
L !‰ û ä p È È •Ú4»4Å ¥ ù Ø7¾,X ì “ ÈE- Ô!9 ü Ù À IGBT 1 •M6,X8V
6NL!5ëNZ ³) Ô š Ü,X Ü 0 Ä

B Ñ Y Õ,X Ö Ax 1 XC m È 2009 H Ñ IGBT ,X Ö ?~ öE' 38.2 “ Žlå
Ö ÈNX ó2010 H Ñ IGBT Ö ?~ õ 41.4 “ Žlå Ö ÈEW 2009 H äKS 8.4% Ä
2011 H å 2012 H Ú ýE' 45.3 å 50.6 “ Žlå Ö È rKS)[Ú ý 9.4% å
11.7% Ä È Y Đ' XNX# IGBT ü 2010 H ü Ñ,X äKS ÚE' 25% 1 þ ÄM6
í û,X Ö LÔ" È Ñ,Å !E-”u Ý Ô 5` H,X IGBT *ó {4“ Ä 1 ñ o4œ0Å v S
*ü È '!8 TMNO qC*E- · Ä

IGBT + U _ J '1u Ä1T/Ä “BJT” Å `4±4ì U _ h J '1u Ä1T/Ä “MOSFET” Å
,ì4§ Ü,X+ _PE | ä s)[Đ ' < È Ä ¶ Y s)[MOSFET Eg 9L kP- È { s)[
ä È ç bPE | È { 1T) Ä Ô GNe)[P-,X i&• È œ Y U J '1u,X ĐEi+ _ " ÈEi
Ö+ # û È 35ë ä,X :+ i&• Ä ü ñ 8V6Ñ £ f Ä ".‡4£#",X È . È K Ü8V6Ñ)[
P- È “ b?~ ö ê*ó { ÈEW ç r,,8V6Ñ N ; ê1 i&•,X IGBT AE ä s)[Đ ' Ö
¥),X # T ÄIGBT ?U*ü ü S+ { • Ä 1 i { Ä5%4°Ei Ä'; ä Ä#C + \$ Ä
Au1k ž"QE:+ \$1 È5à N6Ñ+ 5% ÄP-ÈØJ•CÄ Ä „6Ñ\$d"QE: IGBT ÔEs Z È t S
"-,X h*ü Ö Ä

■ G b "#z,+ \$

"#z,+ \$ ž JL 2 @ ì ÑNZ ,X õ ³ Đ' @ ì È J ï u Ù À Ô ã J Ú .
¹ ÄLš ä+ CÃA'Au ÄLš ä+ CÃ Ö>™# A©` Ú0Ý < Ê - û Đ' ï u S + Ä "#z,+
\$ Om\$ S p Ö @ ì Ä 0597.HK Å È2008 Hz9ù ïNq 31.18 " \$ Ö È Ñ Y !
h û Đ' Eô Ô Ä

■ G b /¥L6,+ \$

/¥L6,+ \$ Ô çK¼ ¢ _,+ \$NZ ³-è0J â Ô ¥,X Ñ0Ý-è0J X È ü ï þ •
å Ø b Ñ YNZ ! È a k Z .),X ä p È Ñ ,+ \$ T ` { ï ¥) 0 ï ZGj
?UBõ) ÄA¹ ü VDMOS ÄIGBT 1 s)[< ÊNZ ³,X-è Ý ` ï H,X T /Ã3 ` ï
. È,Ä !!77È o bM6 å N6Ñ+ 5% ` + |"QE:P¬0Ä h*üNZ ³,X IGBT 2ï ë { • Ô ¥ Ä

„KÏ6(2ï Ž Ö

"#z,+ \$ ÝL\$ @ ì /ß)
+ A± Ö (+86-510) 8180 5021
Ö (+86) 1381203 1495
ô,ó Ö (+86-510) 8580 4647
+ \$F,1... Ö chengj@crmh.com.cn